

1. Полупроводниковые фотоприемники: ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны спектра. Под ред. Стафеева В. И., Анисимова И. Д., Викулина И. М. Москва, Радио и связь, 1984 г., 310 с.
2. Клячкин Л. Е., Лопатина Л. Б., Маляренко А. М., Суханов В. Л. Спектральные характеристики селективных ФП для видимой и УФ областей спектра. Письма в ЖТФ. 1985 г., том 11, в. 6, с. 354-356
3. Гуткин А. А., Дмитриев М. В., Наследов Д. Н., Пашковский А. В. Спектры фоточувствительности поверхностно-барьерного диода Au-n-GaAs в области энергий фотонов 1-5 эВ. ФТП. 1971 г., том 5, вып. 10, с. 1927-1933
4. Беркелиев А., Гольдберг Ю. А., Мелебаев Д., Царенков Б. В. ФП видимого и УФ излучения на основе GaAs<sub>1-x</sub>P<sub>x</sub> поверхностно-барьерных структур. ФТП. 1976 г., том 10, вып. 8, с. 1532-1538
5. Аннаева А. Р., Беркелиев А., Бессолов В. Н., Гольдберг Ю. А., Царенков Б. В., Яковлев Ю. П. ФП УФ излучения на основе варизонной Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>P (X<sub>s</sub>=0,5+0,1) поверхностно-барьерной структуры. ФТП. 1981 г., том 15, вып. 6, с. 1122
6. Малик А. И., Грушка Г. Г. Оптоэлектронные свойства гетеропереходов окисей металла-GaP. ФТП. 1991 г., том 25, вып. 11, с. 1691-1696